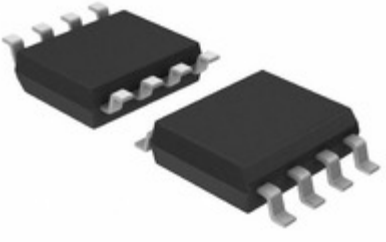



	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4384DY-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  SI4384DY-T1-GE3.pdf</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4384DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.47W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 10A (Ta) 1.47W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Ta)

SI4384DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4384DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4384DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4384DY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4386DY-T1-E3..</b> VISHAY SI4386DY-T1-E3.. VISHAY</p>	 <p><b>SI4384DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4386DY</b> VISHAY SI4386DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4386DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>
 <p><b>SI4384DY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 10A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4384DY</b> VISHAY SI4384DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4386DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4384DY-T1-E3..</b> VISHAY SI4384DY-T1-E3.. VISHAY</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4384DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4384DY-T1-GE3 Datenblatt	SI4384DY-T1-GE3-Datenblätter	SI4384DY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4384DY-T1-GE3
SI4384DY-T1-GE3 Electronic	SI4384DY-T1-GE3-Komponenten	SI4384DY-T1-GE3-Verteiler	SI4384DY-T1-GE3-Bild	SI4384DY-T1-GE3-Teil
SI4384DY-T1-GE3 Preis	SI4384DY-T1-GE3 Hersteller	SI4384DY-T1-GE3 Bild	SI4384DY-T1-GE3 Aktie	SI4384DY-T1-GE3 Inventar
SI4384DY-T1-GE3 Neu	SI4384DY-T1-GE3 Original	SI4384DY-T1-GE3 garantiert	SI4384DY-T1-GE3 RFQ	SI4384DY-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited